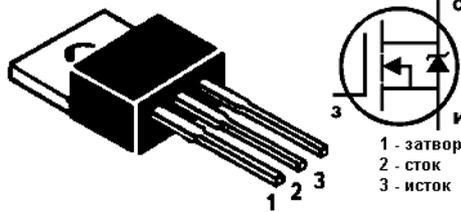


# N-канальный МОП ПТ КП733А.



## Краткий информационный лист

Область применения полевых транзисторов определяется их основными характеристиками:

- Высокие динамические характеристики
- Рабочая температура кристалла 150С
- Низкое сопротивление во включенном состоянии
- Низкая мощность управления
- Высокое коммутируемое напряжение

Применяется для импульсных источников питания совместно с ИМС КР1033ЕУ5А1

### Максимально допустимые значения

Условные обозначения	Параметр	Максимум	Ед.изм.
$I_D @ T_C=25C$	Постоянный ток стока	1.5	А
$I_D @ T_C=70C$	Постоянный ток стока	1.0	А
$I_{DM}$	Импульсный ток стока <sup>(1)</sup>	6.0	А
$P_D @ T_C=25C$	Рассеиваемая мощность	125	Вт
	Линейное снижение мощности рассеивания от температуры	0.2	Вт/С
$V_{GS}$	Напряжение затвор-исток	±20	В
$E_{AS}$	Энергия пробоя одиночным импульсом <sup>(2)</sup>	-	мДж
$I_{AR}$	Ток лавинного пробоя <sup>(1)</sup>	6.0	А
$E_{AR}$	Энергия пробоя повторяющимися импульсами <sup>(1)</sup>	-	мДж
$dv/dt$	Скорость нарастания напряжения на закрытом диоде <sup>(3)</sup>	4.0	В/нс
$T_J$ $T_{STG}$	Диапазон температур функционирования перехода и хранения прибора	от -10 до +150	С
	Температура пайки при времени менее 10 сек.	300	С

### Электрические характеристики @ $T_J = 25C$ (если не указано другое)

Усл. обозначение	Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Режим измерения
$V_{(BR)DSS}$	Максимальное напряжение сток-исток	400	-	-	В	$V_{GS} = 0B$ , $I_D = 100\mu A$
$V_{(BR)DSS}/\Delta T_J$	Температурный коэффициент максимального напряжения	-	0.7	-	В/С	$T = 25C$ , $I_D = 1mA$
$R_{DS(on)}$	Сопротивление сток-исток	-	-	3.6	Ом	$V_{GS} = 10B$ , $I_D = 1.0A$ <sup>(4)</sup>
$V_{GS(th)}$	Пороговое напряжение на затворе	2.0	-	4.0	В	$V_{DS} = V_{GS}$ , $I_D = 10mA$
$g_{fs}$	Кругизна характеристики	0.5	-	-	А/В	$V_{DS} = 20B$ , $I_D = 1.0A$ <sup>(4)</sup>
$I_{DSS}$	Остаточный ток стока	-	-	100	мкА	$V_{DS} = 400B$ , $V_{GS} = 0B$
		-	-	500		$V_{DS} = 400B$ , $V_{GS} = 0B$ , $T_J = 70C$
$I_{GSS}$	Ток утечки затвора (прямой)	-	-	100	нА	$V_{GS} = 20B$
	Ток утечки затвора (обратный)	-	-	-100		$V_{GS} = -20B$

### Характеристики исток-стока

Усл.обозн.	Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.изм.	Режим изм.
$I_S$	Постоянный ток истока(через встроенный диод)	-	-	1.5	А	Условное обозначение полевого транзистора со встроенным диодом
$I_{SM}$	Импульсный ток истока(через встроенный диод) <sup>(1)</sup>	-	-	6		
$V_{SD}$	Прямое напряжение на диоде	-	-	2.5	В	$T_J = 25C$ , $I_S = 1.5A$ $V_{GS} = 0B$ <sup>(4)</sup>

**Примечания:**

- (1) - частота следования; длительн. импульса ограничена максимальной температурой кристалла
- (2) - будет определена при доработке конструкции
- (3) -  $I_{SD} \div 1.5A$ ,  $di/dt \div 150A/мкс$ ,  $V_{DD} \div V_{(BR)DSS}$ ,  $T_J \div 150C$
- (4) - длительн. импульса  $\div 300мкс$ , коэффициент заполнения  $\div 2\%$ .